

## Prof. Dr. Michael M. Krämer, MBA

### Beruflicher Werdegang

---

- Seit 02/2021 Professor für Grundlagen der Elektrotechnik an der **Hochschule München**
- von 01/2015 bis 01/2021 **Qorvo Munich GmbH**  
zuletzt Leiter der Gruppe „Aktive Schaltungsentwicklung“ und „Senior Member of Technical Staff“ (Technischer Expertenstatus bei Qorvo)  
**Verantwortungsbereich:** Leitung der Entwicklung von integrierten aktiven Schaltungen für HF-Frontendmodule am Standort München  
**Thematische Schwerpunkte:** Entwurf hocheffizienter GaAs- Leistungsverstärker und Frontendmodule für die Mobilkommunikation (Standards: GSM / UMTS / LTE / 5G); Entwurf integrierter CMOS SOI-Schalter und LNAs; Co-design/Integration mit SAW/BAW-Filtern; Elektromagnetische Feldsimulation und Schaltungssimulation von Mikrowellenmodulen und Komponenten; Hochfrequenz-Messtechnik
- von 12/2011 bis 12/2014 **Triquint Semiconductor GmbH (seit 01/2015 Teil von Qorvo), München**  
zuletzt „Senior RF Design Engineer“  
**Verantwortungsbereich:** Entwicklung, Simulation und Charakterisierung von integrierten Leistungsverstärkermodulen für UMTS/LTE/5G-Mobilendgeräte
- von 01/2011 bis 11/2011 **Daimler AG, Untertürkheim**  
Einsatz als Juniorberater in der Forschung und Entwicklung elektrischer Antriebe im Rahmen des MBA-Programms des CDI (s.u.)
- von 04/2007 bis 12/2010 **LAAS-CNRS, Toulouse, Frankreich**  
Institut des französischen Forschungsverbundes CNRS ([www.laas.fr](http://www.laas.fr))  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Entwurf integrierter mm-Wellenschaltungen
- von 04/2005 bis 07/2005 **Daimler AG, Untertürkheim**  
Forschungsabteilung für elektrische Antriebe

### Ausbildung

---

- von 01/2011 bis 11/2011 **Collège des Ingénieurs, Paris und München, [www.cdi.fr](http://www.cdi.fr)**  
10-monatiges **MBA – Programm** mit Unternehmensprojekt (Daimler AG, s.o.)
- 12 / 2010 **Université de Toulouse, INSA de Toulouse, Frankreich**  
**Promotion** im Bereich Mikroelektronik  
Thema: „Design of a low-power 60 GHz transceiver front-end and behavioral modeling and implementation of its key building blocks in 65 nm CMOS“  
Ausgezeichnet mit dem **Preis der “école doctorale”**
- von 10/2003 bis 03/2007 **Universität Stuttgart**  
Studium der Elektrotechnik, Schwerpunkt Hochfrequenztechnik  
Abschluss: **Dipl.-Ing. Elektrotechnik**
- von 08/2005 bis 05/2006 **University of Massachusetts, Amherst, USA**  
Auslandsjahr im Rahmen des Studiums an der Universität Stuttgart
- von 10/2000 bis 09/2003 **Duale Hochschule (ehem. Berufsakademie) Mosbach, Baden-Württemberg**  
Studium Elektrotechnik und Informationstechnik / Automatisierungstechnik  
Abschlüsse: **Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik** und **Bachelor of Science (hons)**